



# SEMICONDUCTOR

## TECHNICAL DATA

東芝トランジスタ TOSHIBA TRANSISTOR

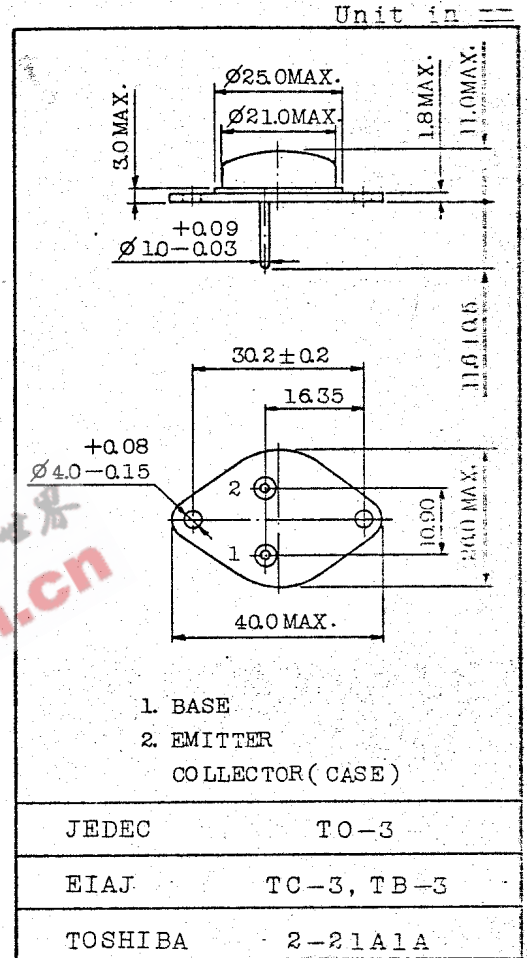
2SC2461A

SILICON NPN EPITAXIAL TYPE (PCT PROCESS)\*

TENTATIVE

○ 電力増幅用

- Power Amplifier Applications.
- 高耐圧です。  $V_{CE0} = 160V$  (MIN.)
- トランジション周波数が高い。  $f_T = 80MHz$  (TYP.)
- 2SA1051A とコンプリメンタリになります。
- 100W Hi-Fi オーディオ・アンプに最適です。
- Complementary to 2SA1051A.
- Recommended for 100W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.



最大定格 MAXIMUM RATINGS (  $T_a = 25^\circ C$  )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	160	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	160	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	15	A
エミッタ電流	$I_E$	-15	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ C$ )	$P_C$	150	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^\circ C$

アクセサリは AC73 を適用  
MOUNTING KIT NO. AC73

\* PCT 技術により製造されています。



# SEMICONDUCTOR

## TECHNICAL DATA

2SC2461A

### 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=160V, I_E=0$	—	—	10	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	50	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1A, I_B=0$	160	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.01A, I_C=0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	55	—	240	—
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5V, I_C=5A$	40	—	—	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5A, I_B=0.5A$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=5V, I_C=5A$	—	—	2.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=10V, I_C=1A$	—	80	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f=1MHz$	—	200	—	pF

Note  $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE}$  the 2SC2461A is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC2461A-R	55	110
2SC2461A-O	80	160
2SC2461A-Y	120	240